

# 제20회 한국반도체학술대회

2013년 2월 4일(월)~6일(수) / 웰리힐리파크 (구, 성우리조트)

우) 302-120 대전광역시 서구 둔산동 1018번지 대한빌딩 5층 / 담당: 최은영 팀장, 김아영  
TEL: (042) 472 -7461 FAX: (042) 472 -7459 E-mail: kcs@cosar.or.kr

## K. Memory (Design & Process Technology) 분과

Room E

스타홀 (본관, 2층)

2013년 2월 6일(수) 12:45-14:00

### [WE2-K] Nonvolatile Memory Techniques I

좌장: 김영희(창원대학교), 조우영(삼성전자)

[초청]

- |         |             |   |
|---------|-------------|---|
| WE2-K-1 | 12:45-13:15 | <b>산화수 변화형 Bipolar 저항변화 메모리의 물질 설계 및 특성</b><br>김영배<br>삼성종합기술원 산화물소자그룹   |
| WE2-K-2 | 13:15-13:30 | <b>플래쉬 메모리 소자에서의 초기 <math>V_T</math> 불안정 현상 개선에 관한 연구</b><br>박종경 <sup>1</sup> , 이석희 <sup>1</sup> , 이기홍 <sup>2</sup> , 피승호 <sup>2</sup> , 조병진 <sup>1</sup><br><sup>1</sup> 한국과학기술원 전기및전자공학과, <sup>2</sup> SK 하이닉스 반도체 메모리 연구소  |
| WE2-K-3 | 13:30-13:45 | <b>Simple Empirical I-V Model for Memristive Switches and Its Application for SPICE Simulation</b><br>김윤혁 <sup>1</sup> , 김대근 <sup>1</sup> , 황인록 <sup>2</sup> , 장재만 <sup>1</sup> , 배학열 <sup>1</sup> , 이재욱 <sup>1</sup> , 전성우 <sup>1</sup> , 조춘형 <sup>1</sup> , 최현준 <sup>1</sup> , 최선웅 <sup>1</sup> , 민경식 <sup>1</sup> , 박배호 <sup>2</sup> , 김동명 <sup>1</sup> , 김대환 <sup>1</sup><br><sup>1</sup> School of Electrical Engineering, Kookmin University, <sup>2</sup> Division of Quantum Phases and Devices, Department of Physics, Konkuk University |
| WE2-K-4 | 13:45-14:00 | <b>Resistive Switching Characteristics in Wet Deposited <math>Ag_2Se/GeSe</math> Bilayer Structured Resistive Random Access Memory (ReRAM)</b><br>김장한, 남기현, 조원주, 정홍배<br>광운대학교 전자재료공학과   |